

ПРОТОКОЛ № 20/2018
Заседания Конкурсной Комиссии
на замещение вакантных должностей научных работников
Федерального государственного автономного научного учреждения
Института сверхвысокочастотной полупроводниковой электроники
имени В.Г. Мокерова Российской академии наук

г. Москва

28 сентября 2018 г.

Присутствовали:

Председатель комиссии	- доктор технических наук, профессор, директор ИСВЧПЭ РАН С.А.Гамкрелидзе
Заместитель председателя комиссии	- кандидат физико-математических наук, доцент заместитель директора по научной работе ИСВЧПЭ РАН Д.С. Пономарев
Секретарь комиссии	- кандидат физико-математических наук, ученый секретарь ИСВЧПЭ РАН Р.А. Хабибуллин
Члены комиссии:	- кандидат технических наук, председатель Профкома ИСВЧПЭ РАН А.Ю. Павлов - доктор технических наук, профессор, зам. ген. директора по научной работе ОАО «НПП «Пульсар» Ю.В. Колковский - член-корреспондент РАН, врио директора ФТИАН В.Ф. Лукичев - доктор технических наук, профессор, зам. директора НИИВТ им С.А. Векшинского С.Б. Нестеров

Всего: 7 человек из 7 членов Конкурсной комиссии.

Повестка дня: Проведение конкурса на замещение вакантной должности научного сотрудника лаборатории № 106 «Лаборатория исследования и разработки комплексной технологии формирования полупроводниковых микро- и наноструктур, малошумящих и мощных наногетероструктурных СВЧ-транзисторов и МИС на их основе».

Слушали:

1. Председатель Конкурсной комиссии ИСВЧПЭ РАН д.т.н., профессор С.А. Гамкрелидзе проинформировал участников заседания о том, в Конкурсную комиссию ИСВЧПЭ РАН поступило заявление и комплект документов, необходимых для проведения конкурса, от Слаповского Дмитрия Николаевича для избрания его на должность научного сотрудника «Лаборатории исследования и разработки комплексной технологии формирования полупроводниковых микро- и наноструктур, малошумящих и мощных наногетероструктурных СВЧ-транзисторов и МИС на их основе». Директор зачитал характеристику Слаповского Д.Н. подписанную заведующим лабораторией №106 Павловым А.Ю. В ней, в частности отмечается, что в процессе работы в ИСВЧПЭ РАН Слаповский Д.Н. выполнял различные исследовательские задачи экспериментального и теоретического характера: проводил процессы напыления

различных систем металлизации, произвел модернизацию установок вакуумного напыления и разработал оснастки для проведения процессов напыления, принимал активное участие в пусконаладочных работах УВН с реализованным методом электронно-лучевого испарения, участвовал в разработках новой системы металлизации к перспективным нитридным гетеросистемам на основе AlGaN/GaN, результатом которых стало получение патента на изобретение. Научные интересы Слаповского Д.Н. лежат в области технологии мощных и маломощных СВЧ-транзисторов на полупроводниках группы АЗВ5. Им выполнялись исследования по оптимизации технологии формирования омических контактов к нитридным и арсенидным гетеросистемам. Слаповский Д.Н. активно участвовал в подготовке и выполнении научно-исследовательских работ и грантов ИСВЧПЭ РАН.

Слаповский Д.Н. является соавтором более 6 статей в ведущих отечественных научных журналах и 1 патента на изобретение. Результаты исследований неоднократно представлялись лично Слаповским Д.Н. на отечественных и международных научных конференциях. В процессе работы в ИСВЧПЭ РАН он проявил себя квалифицированным специалистом в области комплексной технологии полупроводниковых маломощных и мощных СВЧ транзисторов и МИС на их основе, способным к самостоятельной научно-исследовательской работе.

Документы удовлетворяют квалификационным характеристикам.

Больше заявок на занятие этой должности в Конкурсную комиссию не поступало.

Постановили:

По 1-му пункту повестки дня:

1) Согласно п. 11 Приложения № 2 к Приказу Минобрнауки РФ от 02.09.2015 № 937 в продлении срока рассмотрения заявок для проведения собеседования с претендентом необходимости нет.

2) Признать конкурс на замещение вакантной должности научного сотрудника лаборатории № 106 «Лаборатории исследования и разработки комплексной технологии формирования полупроводниковых микро- и наноструктур, маломощных и мощных наногетероструктурных СВЧ-транзисторов и МИС на их основе» состоявшимся в объявленные сроки.

3) Согласно п. 12 Приложения № 2 к Приказу Минобрнауки РФ от 02.09.2015 № 937 по итогам рассмотрения заявки Конкурсная комиссия составила рейтинг претендента на основании балльной оценки, выставленной членами Конкурсной комиссии претенденту, исходя из сведений, содержащихся в заявке и иных прикрепленных к заявке материалах, которые наиболее полно характеризуют квалификацию, опыт и результативность претендента, Конкурсная комиссия приняла решение избрать на должность:

- научного сотрудника «Лаборатории исследования и разработки комплексной технологии формирования полупроводниковых микро- и наноструктур, маломощных и мощных наногетероструктурных СВЧ-транзисторов и МИС на их основе».

– Слаповского Дмитрия Николаевича.

Председатель Конкурсной комиссии
д.т.н., профессор
Секретарь Конкурсной комиссии
к.ф.-м.н.

«28» сентября 2018 г.



С.А. Гамкредидзе

Р.А. Хабибуллин